

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公表番号】特表2016-506620(P2016-506620A)

【公表日】平成28年3月3日(2016.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2016-013

【出願番号】特願2015-547452(P2015-547452)

【国際特許分類】

H 01 L	27/146	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	21/28	(2006.01)
H 01 L	31/10	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/14	C
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 9 A
H 01 L	29/78	6 1 3 Z
H 01 L	29/78	6 1 8 Z
H 01 L	29/78	6 2 6 C
H 01 L	21/28	3 0 1 B
H 01 L	31/10	A

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月27日(2016.12.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 3 1】

ここで、金属酸化物層40がTFT42とPINダイオード20の間の透明なコンタクト層として役立つ点に留意する必要がある。透明な接点(TFT42とフォトダイオード20間の金属酸化物層40)は、金属酸化物エッチマスク(4回目のマスク工程)、エッチストップマスク(5回目のマスク工程)およびS/D電極エッチマスク(6回目のマスク工程)を通して作製される。このように、フォトダイオード20の透明なトップ電極を形成するにあたって更なる堆積またはマスキング工程を必要としない。